

**MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION**  
**PUBLIC RELATIONS DIVISION**  
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8310 Japan

**FÖR OMEDELBAR PUBLICERING**

**Nr 3085**

*Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.*

*Kundförfrågningar*

Power Device Overseas Marketing Dept.A och Dept.B  
Mitsubishi Electric Corporation

[www.MitsubishiElectric.com/semiconductors/](http://www.MitsubishiElectric.com/semiconductors/)

*Medieförfrågningar*

Public Relations Division  
Mitsubishi Electric Corporation  
[prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp](mailto:prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp)  
[www.MitsubishiElectric.com/news/](http://www.MitsubishiElectric.com/news/)

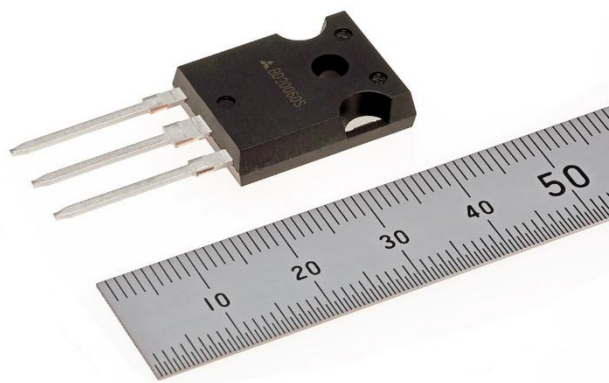
## **Mitsubishi Electric lanserar en Schottky-diod av kiselkarbid**

*Den minskar både strömförlust och strömförsörjningssystemens fysiska storlek*

**TOKYO, 1 mars 2017** – [Mitsubishi Electric Corporation](http://www.mitsubishielectric.com) (TOKYO: 6503) meddelade idag lanseringen av en Schottky-diod av kiselkarbid (SiC-SBD) som införlivar en JBS-struktur (junction-barrier Schottky). Den kommer omedelbart att minska både strömförlusten och den fysiska storleken av strömförsörjningssystem för bland annat luftkonditionering och solcellssystem.



SiC-SBD (BD20060T)



SiC-SBD (BD20060S)

## **Produktegenskaper**

### **1) *Kiselkarbid ger lägre strömförbrukning och mer kompakt storlek***

- En förbättrad energiförbrukning innebär en besparing på ungefär 21 % i jämförelse med silikonprodukter (Si)
- Det genererar höga switchfrekvenser och en storleksminskning av perifera komponenter som reaktorer

### **2) *Ökad tillförlitlighet tack vare JBS-strukturen (junction-barrier Schottky)***

- Schottkybarriären kombineras med p-n junction
- JBS-strukturen bidrar till en hög tillförlitlighet

## **Säljschema**

Serie	Modell	Kapsel	Specifikation	Frakt
SiC-SBD	BD20060T	TO-220	20A/600V	1 mars 2017
	BD20060S	TO-247		1 september 2017

## **Huvudspecifikationer**

Modell	BD20060T	BD20060S
Specifikation	20A/600V	
Ökade oregelbundna framspänningsfall	155A (8,3 ms, sinusvåg)	
Diodens framåtspänning	1.35V	
Kapsel	TO-220	TO-247
Mått	10,1×29,0 mm	15,9×41,0 ×5,0 mm

Mitsubishi Electric började kommersialisera effektmoduler som införlivade SiC-enheter år 2010, och har sedan dess fortsatt att bidra till att miniaturisera och öka energieffektiviteten av växelriktarsystem. Efterfrågan har ökat efter energieffektiva strömförsörjningssystem till luftkonditionering, solcellssystem, med mera, och konsumenter väljer allt oftare produkter som införlivar SiC-SBD.

## **Miljömedvetenhet**

Produkterna uppfyller direktivet för begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (RoHS) 2011/65/EU.

Observera: Utvecklingen av dessa produkter har delvis gjorts med stöd av Japan's New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO).

###

### **Om Mitsubishi Electric Corporation**

Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) har över 90 års erfarenhet av att tillhandahålla tillförlitliga och högkvalitativa produkter och är en erkänd global ledare inom tillverkning, marknadsföring och försäljning av elektrisk och elektronisk utrustning som används i behandling av information och kommunikation, rymdteknik och satellitkommunikation, konsumentelektronik, industriteknik, energi-, transport- och byggtutrustning. Mitsubishi Electric strävar efter att vara ett globalt och ledande grönt företag som berikar samhället med teknik genom att anamma andemeningen i företagets motto, Changes for the Better, och dess miljöredovisning, Eco Changes. Företaget noterade att koncernens försäljning hamnade på 4 394,3 miljarder yen (38,8 miljarder dollar\*) under räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2016.

Besök följande för mer information:

[www.MitsubishiElectric.com](http://www.MitsubishiElectric.com)

\*Med en växelkurs på 113 yen till den amerikanska dollarn, vilket är kursen som givits av Tokyobörsen den 31 mars 2016